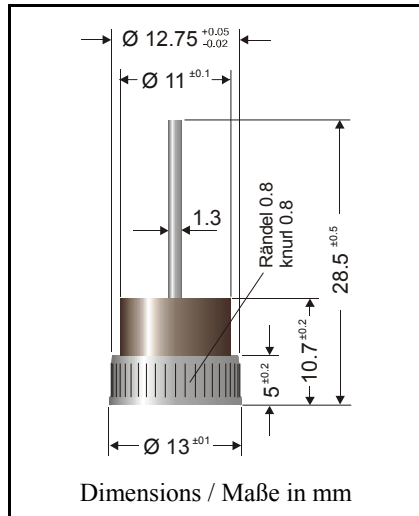


**Silicon Protectifiers
 with TVS characteristics
 High-temperature diodes**

**Silizium Schutzgleichrichter
 mit Begrenzereigenschaften
 Hochtemperaturdioden**



Nominal current – Nennstrom 35 A
 Nominal breakdown voltage 19.8 ... 51.7 V
 Nominale Abbruch-Spannung
 Metal press-fit case with plastic cover
 Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung
 Weight approx. – Gewicht ca. 10 g
 Casting compound has UL classification 94V-0
 Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert
 Standard packaging: bulk
 Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings

Grenzwerte

Type / Typ Wire to / Draht an		Breakdown voltage Abbruch-Spannung $I_T = 100 \text{ mA}$		Reverse voltage Sperrspannung $I_R = 5 \mu\text{A}$	Max. clamping voltage Max. Begrenzerspannung at / bei $I_{PP}, t_p = 1 \text{ ms}$	
Anode	Cathode	$V_{BRmin} \text{ [V]}$	V_{BRmax}	$V_R \text{ [V]}$	$V_C \text{ [V]}$	$I_{PP} \text{ [A]}$
BYZ 35A22	BYZ 35K22	19.8	24.2	> 17.8	31,9	161
BYZ 35A27	BYZ 35K27	24.3	29.7	> 21.8	39,1	128
BYZ 35A33	BYZ 35K33	29.7	36.3	> 26.8	47,7	106
BYZ 35A39	BYZ 35K39	35.1	42.9	> 31.6	56,4	89
BYZ 35A47	BYZ 35K47	42.3	51.7	> 38.1	67,8	75

Max. average forward rectified current, R-load $T_C = 150^\circ\text{C}$ I_{FAV} 35 A
 Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last

Peak forward surge current, 50 / 60 Hz half sine-wave $T_A = 25^\circ\text{C}$ I_{FSM} 360 / 400 A
 Stoßstrom für eine 50 / 60 Hz Sinus-Halbwellen

Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ $T_A = 25^\circ\text{C}$ i^2t 660 A²s
 Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$

Forward voltage $T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 35 \text{ A}$ V_F < 1.1 V
 Durchlaßspannung

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T_j – 50...+215°C
 Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s – 50...+215°C

Max. junction temperature in case of "Load Dump"
Max. Sperrschichttemperatur bei "Load Dump"

T_{jmax} +280°C

Thermal resistance junction to case
Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse

R_{thC} < 0.8 K/W

Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck

7 kN

